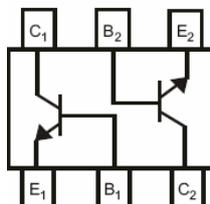


DUAL TRANSISTOR (NPN)

FEATURES

- Epitaxial Die Construction
- Complementary PNP Type Available (BC857BV)
- Ultra-Small Surface Mount Package



Marking: K4V

MAXIMUM RATINGS($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Value	Units
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	50	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	45	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	6	V
I_C	Collector Current -Continuous	0.1	A
P_C	Collector Power Dissipation	0.15	W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance. Junction to Ambient Air	833	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
T_J	Junction Temperature	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector-base breakdown voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	50			V
Collector-emitter breakdown voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$	45			V
Emitter-base breakdown voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\mu\text{A}, I_C=0$	6			V
Collector cut-off current	I_{CBO}	$V_{CB}=30\text{V}, I_E=0$			15	nA
Emitter cut-off current	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$			100	nA
DC current gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$	200		450	
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$ $I_C=100\text{mA}, I_B=5\text{mA}$			100 300	mV
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$ $I_C=100\text{mA}, I_B=5\text{mA}$		700 900		mV
Base-emitter voltage	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	580	660	700 770	mV
Transition frequency	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	100			MHz
Output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$			4.5	pF
Noise Figure	NF	$V_{CE}=5\text{V}, R_s=2\text{k}\Omega,$ $f=1\text{kHz}, BW=200\text{Hz}$			10	dB

Typical Characteristics

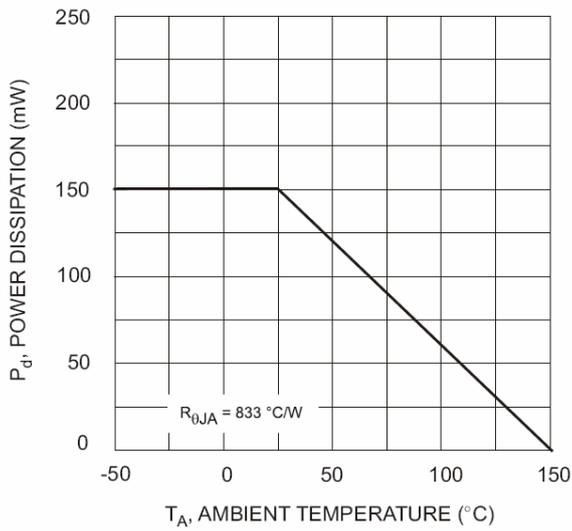


Fig. 1, Derating Curve - Total

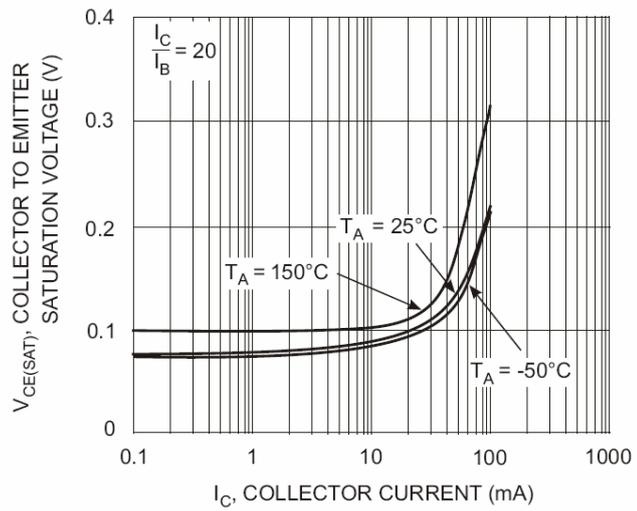


Fig. 2, Collector Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

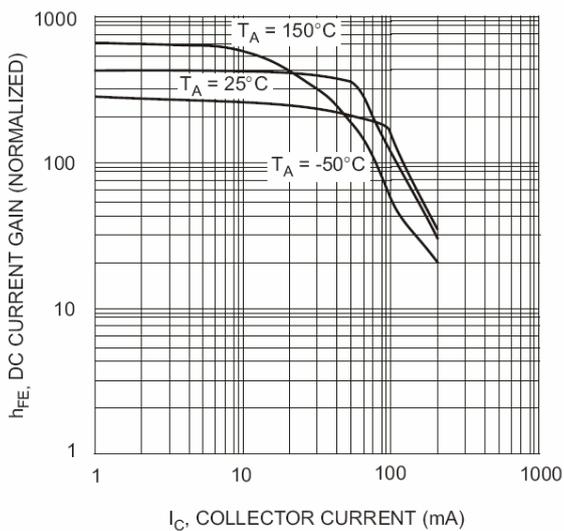


Fig. 3, DC Current Gain vs. Collector Current

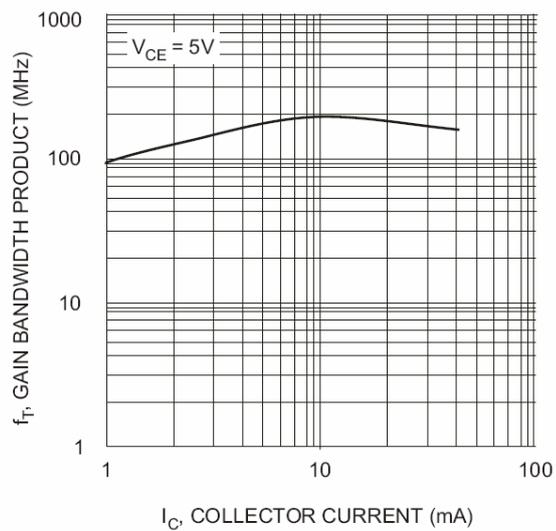


Fig. 4, Gain Bandwidth Product vs. Collector Current



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331